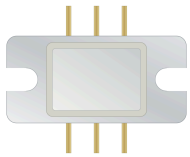
1200–1600 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT ≥ 42 dBm

LCI-PA-1200-1600-PS42MIN · 1200–1600 MHz · GaN Gehäuster Leistungsverstärker.



Kennwerte der RF-Tabelle: PSAT ≥ 42 dBm; Leistungsverstärkung ≥ 16 dB; PAE 55 % (typisch). RF-Prüfbedingungen: Vd = +28 V; Vg = -1.8; D = 10%; Pin = 26 dBm.

CMW010B

Zuerst Gate-, dann Drain-Vorspannung anlegen. Zuerst Drain-, dann Gate-Vorspannung entfernen.

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

Gehäuseabmessungen: 18.03 × 8.7 mm.

RF-Kennwerte

Vd = +28 V; Vg = -1.8; D = 10%; Pin = 26 dBm

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Betriebsfrequenz	f	1200	-	1600	MHz
Sättigungsausgangsleistung	-	42	-	-	dBm
Leistungsverstärkung	-	16	-	-	dB
Leistungsaddierte Effizienz	-	45	55	-	%
Welligkeit der Leistungsverstärkung	-	-	-	1	dB

DC-Bias und Strom

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Wert	Einheit
Drainspannung	-	-	-	-	28	V
Gatespannung	-	-	-	-	-1.8	V

Grenzwerte

Grenzwerte; keine Sollwerte für den Normalbetrieb.

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Maximale Drain-Source-Spannung	-	-	-	32	V
Minimale Gate-Vorspannung	-	-5	-	-	V

Grenzwerte

Grenzwerte; keine Sollwerte für den Normalbetrieb.

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Lagertemperatur	-	-65	-	150	°C
Maximale Eingangsleistung	-	-	-	30	dBm
Maximale Kanaltemperatur	-	-	-	225	°C

Gehäuseabmessungen

Parameter	Wert	Einheit
Gehäuseabmessungen	18.03 × 8.7	mm
Anschlussspannweite	14.7	mm

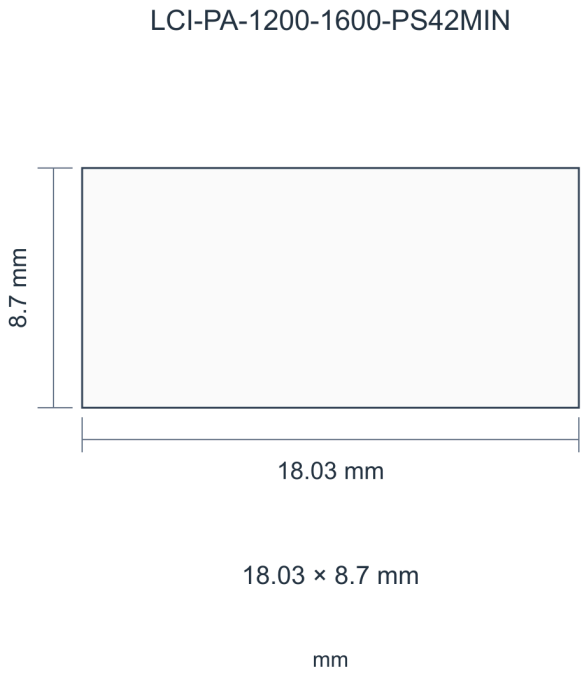
Aktueller Publikationsstand · 1.6 · 2026-11-12. Produktbeschreibung oder redaktionelle Inhalte wurden aktualisiert. Ersetzt Revision 1.5.

Integrationshinweise

CMW010B Zuerst Gate-, dann Drain-Vorspannung anlegen. Zuerst Drain-, dann Gate-Vorspannung entfernen. Vg: C = 10 µF Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

Mechanische Maßzeichnung

Teilzeichnung mit bestätigten Abmessungen in mm. Für die Montage ist der vollständige Montageplan erforderlich.

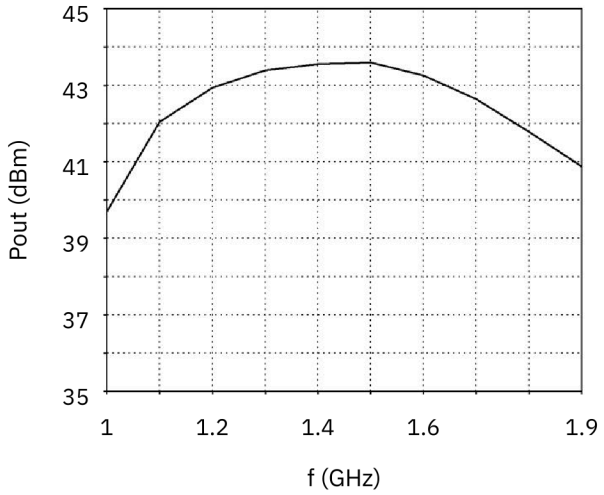


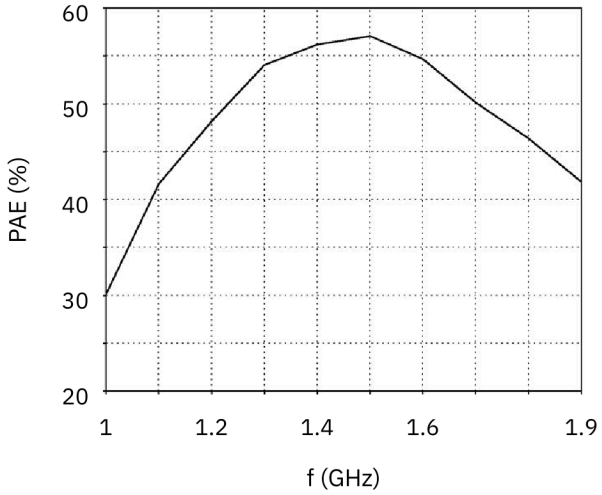
Kennlinien

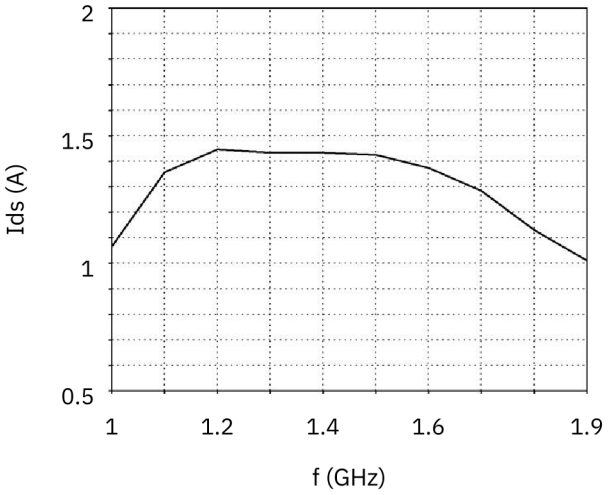
Für jedes Diagramm gelten die jeweils angegebenen Betriebsbedingungen.

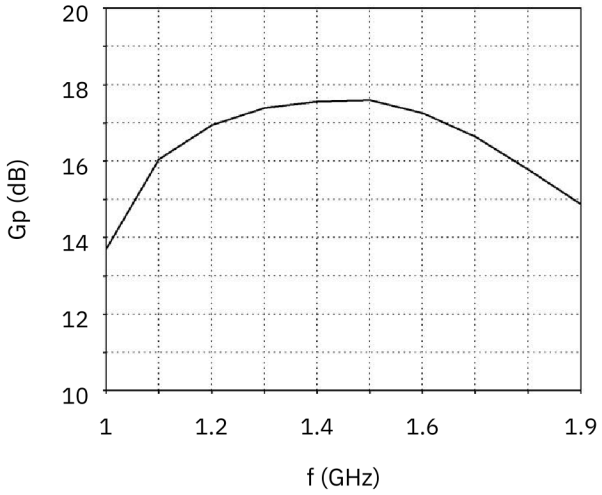
Sättigungsausgangsleistung; Leistungsaddierte Effizienz; Dynamischer Drainstrom; Leistungsverstärkung.

Hinweise zur Abbildung: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-1.8V; Pin=26dBm. D = 10%.



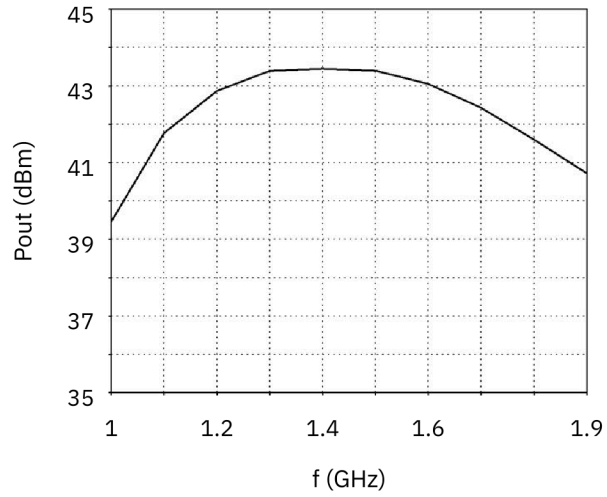


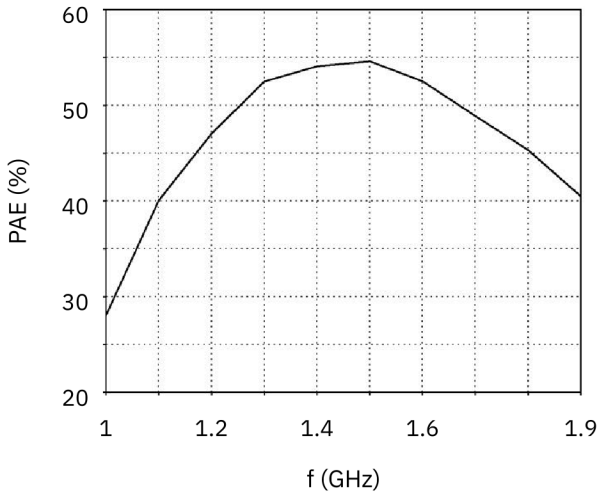


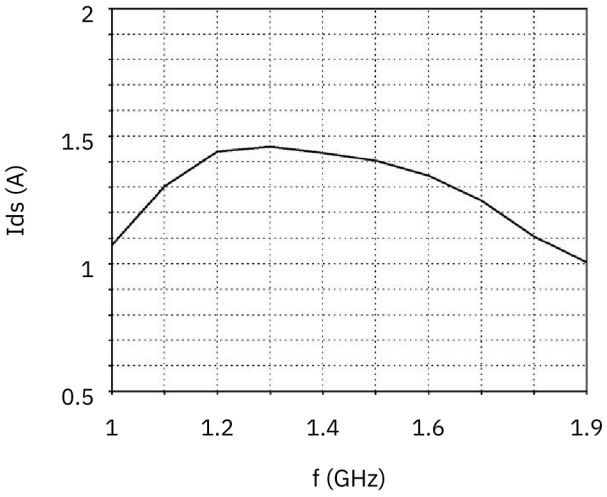


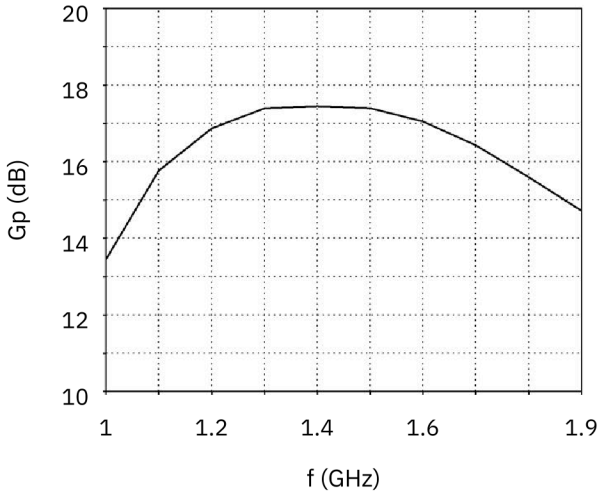
Dauerstrich (CW) — Sättigungsausgangsleistung; Leistungsaddierte Effizienz; Dynamischer Drainstrom; Leistungsverstärkung.

Hinweise zur Abbildung: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-1.8V; Pin=26dBm.









Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.